

電子デバイス

合同研究会

半導体電力変換

〔委員長〕石原 宏（東工大）
〔幹 事〕和田恭雄（早 大），益 一哉（東工大），高橋琢二（東 大）

〔委員長〕斎藤涼夫（東 芝）
〔幹 事〕千葉 明（東京理科大），小倉常雄（東 芝）
〔幹事補佐〕竹下隆晴（名工大），藤田英明（東工大）

日 時 11月28日（木） 13：00～16：50
29日（金） 9：00～17：00

会 場 高知大学理学部朝倉キャンパス（高知市曙町2-5-1，高知空港から車約45分，空港バス約50分，詳細は<http://www.kochi-u.ac.jp/JA/annai/kotu.html>をご覧ください。

協 賛 パワーデバイス・パワーIC技術調査専門委員会（委員長 関 康和，幹事 四戸 孝，高田育紀，幹事補佐 岩室憲幸）

議 題 テーマ「パワーデバイス・ICとそのインテリジェント化技術／半導体電力変換一般」

11月28日（木）13：00～16：50

EDD-02-83 DSPベース適応型ニューラルネットワーク高調波電流の推定器と評価

SPC-02-113 M.Rukonuzzaman, 西田克巳，中岡睦雄（山口大）

EDD-02-84 高調波トランスを用いたZCS-PFM直列共振形コンバータとZVS-PFM並列共振形コンバータ

SPC-02-114 ータ 苗井 健，石飛 学，中村萬太郎，Laknath Gamage, 中岡睦雄（山口大）

EDD-02-85 共振ACリンク方式三相電圧形インバータの電磁ノイズ評価

SPC-02-115 吉田正伸，平木英治，中岡睦雄（山口大）

EDD-02-86 埋め込みp層によるSBDの超低オン抵抗化

SPC-02-116 斎藤 渉，大村一郎，都鹿野健一，小倉常雄，大橋弘道（東 芝）

EDD-02-87 120Vマルチリサーフ型ジャンクションバリアショットキーダイオード(MR-JBS)

SPC-02-117 九里伸治，北田瑞枝，大島宏介，菅井昭彦（新電元工業）

EDD-02-88 電荷蓄積ダイオード（CSD）における逆回復損失の検討
 SPC-02-118 山崎みや，小林秀雄，篠原信一（オリジン電気）

EDD-02-89 120V BiC-DMOSプロセス開発 - 42Vバッテリーシステム，FPDシステムの高機能化 -
 SPC-02-119 寺島知秀，山本文寿，畑迫健一，日根史郎（三菱電機）

EDD-02-90 高効率DC/DCコンバータ向け低オン抵抗・低容量横型パワーMOSFET
 SPC-02-120 白石正樹，坂本光造，岩崎貴之（日立）

11月29日（金）9：00～12：10

EDD-02-91 高速ゲート電圧制御による多並列MOSFETの損失均等化
 SPC-02-121 奥田達也，浦壁隆浩，角田義一，浅井孝公（三菱電機）

EDD-02-92 高周波SOIパワーMOSFETの線形増幅特性
 SPC-02-122 松本 聡，平岡靖史（NTT）

EDD-02-93 待機電力を大幅に削減する電源用パワーIC
 SPC-02-123 山西雄司，森 吉弘，高橋 理，山下哲司，諸田尚彦（松下電器産業）

EDD-02-94 フルCMOS，低コストSOIワンチップインバータIC
 SPC-02-124 中村和敏，陳 少勤，新井晴輝，佐藤久美子，鈴木史人，川野友広
 高橋一郎，高木洋介，大沢靖男，中川明夫（東芝）

EDD-02-95 ハイブリッドカー用インテリジェントパワーモジュール
 SPC-02-125 深田雅一，ゴラブ マジュー ムダ ル，高梨 健，前川博敏，赤澤彰則（三菱電機）

EDD-02-96 電圧駆動型デバイスの低ゲート電圧駆動における発振現象の解析
 SPC-02-126 長畦文男，田上三郎，桐畑文明（富士電機）
 簗谷由成，山田忠則，藤平龍彦（富士日立パワーセミコンダクタ）

EDD-02-97 IGBTが負荷短絡動作で示す瞬時破壊の機構
 SPC-02-127 高田育紀（三菱電機）

11月29日（金）13：40～14：55

EDD-02-98 1200V系トレンチゲート型フィールドストップIGBTの短絡特性の解析
 SPC-02-128 大月正人（富士日立パワーセミコンダクタ）
 金丸 浩，吉原克彦（富士電機総合研究所），桐沢光明，関 康和（富士電機）

EDD-02-99 6.5kV プレーナ形IGBTチップの開発

SPC-02-129

石澤慎一, 望月浩一 (福菱セミコンエンジニアリング)

末川英介, 井浦真一, 佐藤克巳 (三菱電機)

EDD-02-100 SiGe/Siヘテロ接合コレクタによるトレンチIGBTの低損失化

SPC-02-130

工藤嗣友, 浅野種正 (九州工大)

15 : 10 ~ 17 : 00

パネル討論「次世代パワーデバイスは SiC, GaN, またはまだまだ Si?」